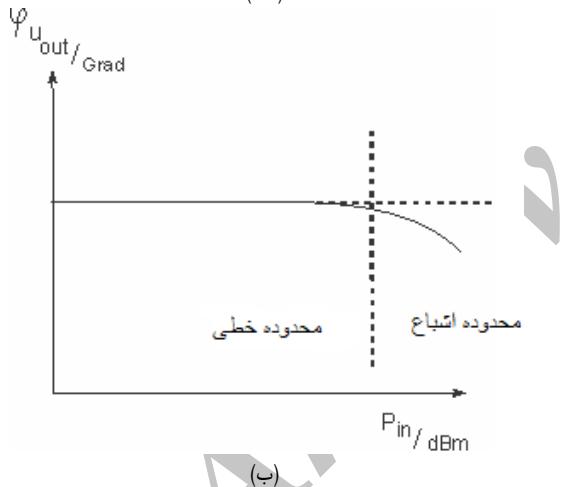
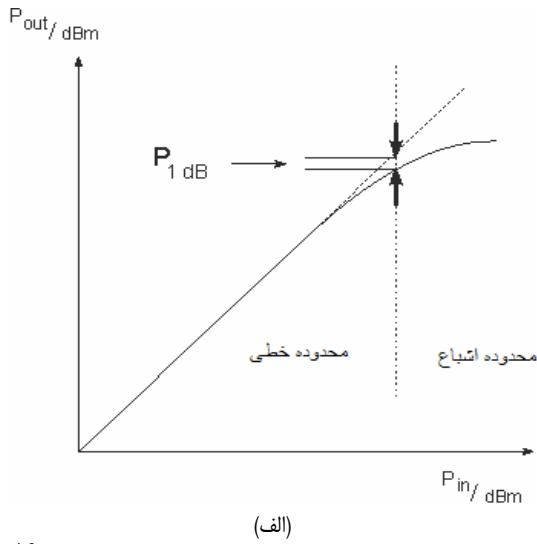


# خطی‌سازی تقویت‌کننده‌های توان بالا با استفاده از روش Feed Forward اصلاح شده

محمد رضا متولی کسمائی و کلاوس سولباخ



شکل ۱: مشخصه خروجی به ورودی تقویت‌کننده توان بالا، (الف) تابع تبدیل توان و (ب) تابع تبدیل فاز و لذتاز.

عبارت‌های درجات بالاتر، بیشتر و مهم‌تر می‌شود یعنی رفتار تقویت‌کننده دیگر خطی نیست و تقویت‌کننده رفتار غیرخطی دارد. این موضوع می‌تواند به وضوح در مشخصه‌های توابع تبدیل AM/PM و AM/AM در شکل ۱ دیده شود. محدوده اشباع به لحاظ توان خروجی بالا و در نتیجه بازدهی بالای آن در سیستم‌های ارتباطات موبایل و ماهواره‌ای نقش مهمی را بازی می‌کند و سیگنال‌های مزاحم با دامنه‌های بزرگ در این محدوده از تقویت‌کننده تولید شده که منجر به تغییر شکل‌های بزرگ در خروجی می‌شوند. به طور کلی عامل غیر خطی برای یک تقویت‌کننده می‌تواند در دو فرم مختلف ظاهر شود، تولید مؤلفه فرکانس‌های جدید در خروجی تقویت‌کننده یا وابستگی دامنه و فاز بهره تقویت‌کننده به دامنه سیگنال یا سیگنال‌های ورودی و به عبارت دیگر انحراف بهره تقویت‌کننده برای دامنه‌های بزرگ (شکل‌های ۲-ب و ۳-ب).

**چکیده:** این مقاله یک مدار اصلاح شده برای بهبود خطی‌سازی تقویت‌کننده‌های توان بالا بر اساس مدل مدار تقویت‌کننده فیدفوروارد ارائه می‌دهد. به کمک مدل ریاضی المان‌های مورد استفاده، مدار اصلاح شده شبیه‌سازی، ساخته و اندازه‌گیری شده است. مدل تقویت‌کننده توان بالا، به وسیله تقریب دامنه تابع تبدیل و فاز بهره تقویت‌کننده (که به دامنه ورودی وابسته است) با استفاده از سری تیلور مختلط که فرم ساده‌شده سوی ولترا است، انجام گرفت. در اثبات کارکرد عملی طرح، متوجه شده‌ایم که تنظیمات مدار به شرایط هدایت تقویت‌کننده‌ها بستگی دارد و خطی‌شدن سیگنال‌ها فقط برای یک محدوده باریکی از توان ورودی (با دامنه ورودی) قابل دسترسی است. قسمت اعظم شبیه‌سازی کل مدار به وسیله مدل ناشی از مشخصه‌های تابع تبدیل دو تقویت‌کننده توان بالا تعیین شده است. مدار جدید در مقایسه با تقویت‌کننده فیدفوروارد متدالو، ضمن افزایش قابل ملاحظه بازدهی، توان سیگنال‌های مزاحم نوع ۳IMD را نیز در دامنه‌های ورودی بزرگ (سیگنال‌های بزرگ) کمینه می‌کند.

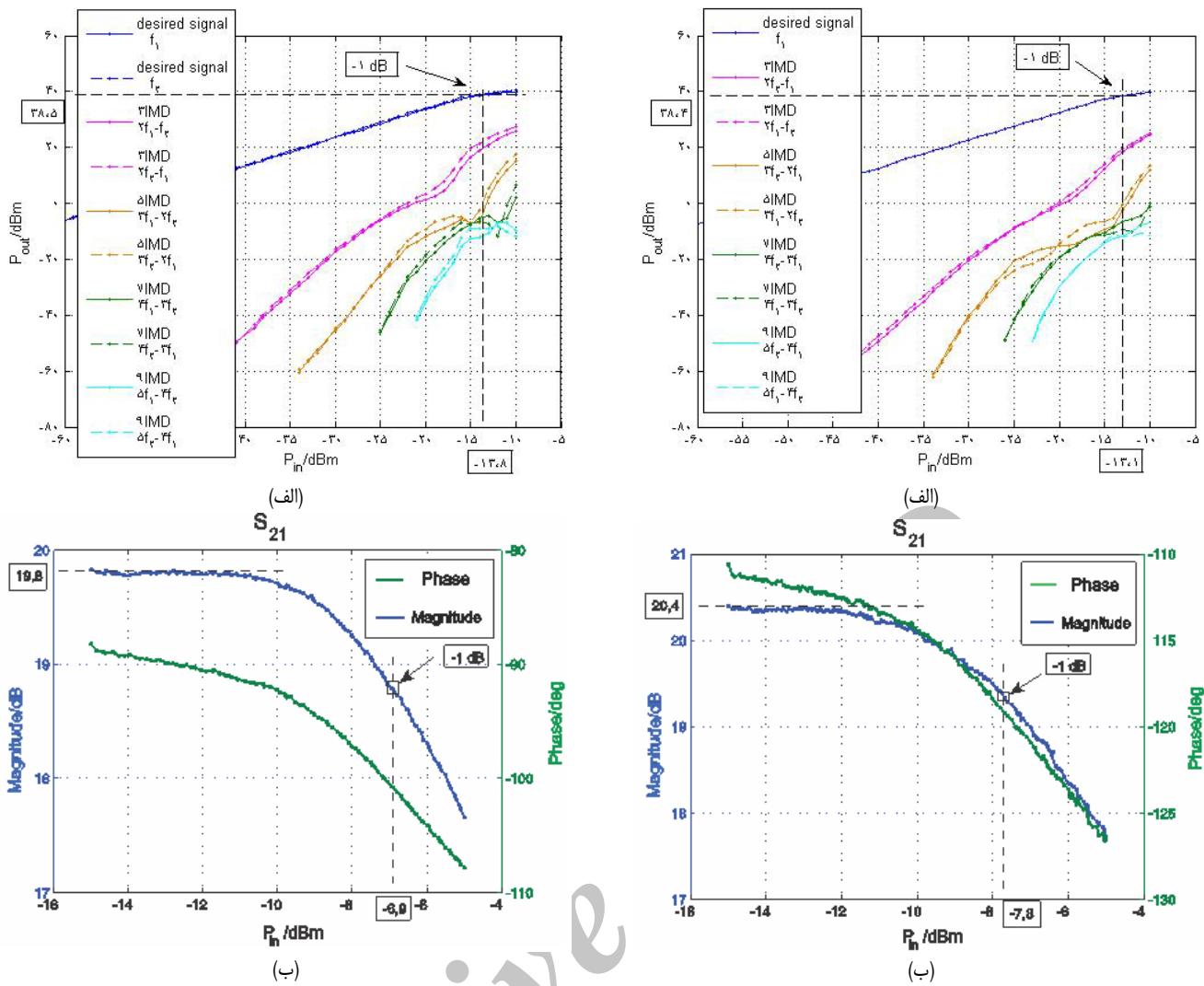
**کلیدواژه:** تقویت‌کننده توان بالا، تقویت‌کننده فیدفوروارد، سوی ولترا، سیگنال‌های نوع ۳IMD.

## ۱- مقدمه

استفاده از تقویت‌کننده‌های توان بالای RF با قابلیت خطی بالا برای سیستم‌های ارتباطات موبایل و ماهواره‌ای امری ضروریست. به عنوان مثال در سیستم‌های موبایل نسل دوم<sup>۱</sup> GSM و سوم<sup>۲</sup> ۳GPP تعداد زیادی سیگنال با فرکانس‌های متفاوت به طور همزمان از تقویت‌کننده‌های توان بالا در ایستگاه‌های زمینی<sup>۳</sup> BS ارسال می‌شوند [۱]. برای جلوگیری از تداخل سیگنال‌های تقویت‌شده خروجی، رفتار این تقویت‌کننده‌ها باید کاملاً خطی باشد و خطی کردن آنها به روش کلاسیک امکان ندارد. دامنه سیگنال‌های مزاحم در خروجی تقویت‌کننده‌ها به بزرگی دامنه سیگنال‌های ورودی بستگی دارد و از این رو سیگنال‌های ورودی با دامنه‌های بزرگ، عملکرد تقویت‌کننده‌ها را محدود می‌کنند. اگر ارتباط بین سیگنال‌های خروجی و ورودی یک تقویت‌کننده را در قالب یک تابع تبدیل نمایش دهیم که در فرم یک سری (به عنوان مثال سری تیلور) بسط داده شده باشد، مشاهده می‌کنیم که برای دامنه‌های بزرگ‌تر، نقش

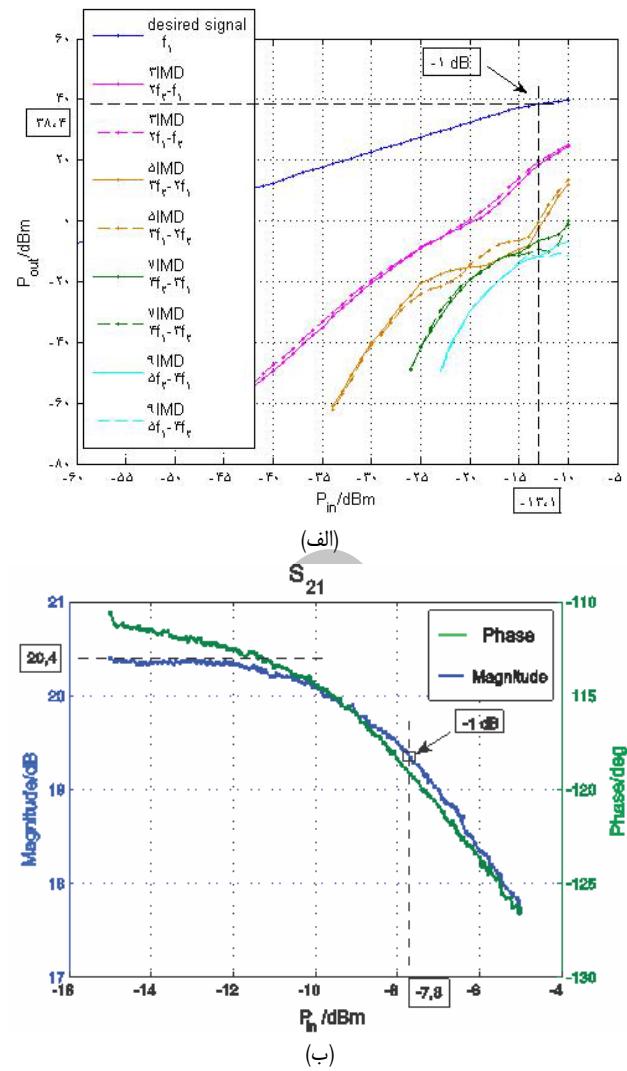
این مقاله در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۳ دریافت و در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۴ بازنگری شد.  
محمد رضا متولی کسمائی، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کلاوس سولباخ، گروه مخابرات- فرکانس‌های بالا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه دیسبورگ، دیسبورگ، آلمان، (email: hft@uni-due.de).

1. Global System Mobile
2. Generation Partnership Project
3. Base Station



شکل ۳: اندازه‌گیری‌های تابع تبدیل تقویت‌کننده  $A$  بر حسب توان ورودی، (الف) سیگنال‌های اصلی و IMD درجهات مختلف و (ب) قدر مطلق و فاز بهره ولتاژ.

شکل ۱- الف) عمل می‌کند. هنگامی که پوش سیگنال‌های ورودی ثابت نباشد و بین یک مقدار بیشیه و کمینه تغییر کند کار دشوار می‌شود (به عنوان مثال برای حالت سیگنال ورودی با بیش از یک فرکانس) و از آنجایی که حداکثر توان پوش کل سیگنال‌های ورودی برابر با جمع توان متوسط تک‌تک سیگنال‌ها است، تقویت‌کننده با یک دامنه بزرگ در ورودی خود مواجه است و از کل مشخصه تابع تبدیل خود (محدوده خطی و غیر خطی در شکل ۱- الف) بهره می‌جوید. ارتفاع توان پوش سیگنال‌های ورودی با بزرگی دامنه سیگنال‌ها و تعداد آنها نسبت مستقیم دارد. معمولاً تقویت‌کننده‌ها طوری هدایت می‌شوند که حداکثر ارتفاع توان پوش سیگنال‌های ورودی، برابر یا کمتر از ۱ dB compression point از این توان تقویت‌کننده باشد. وقتی توان پوش سیگنال‌های ورودی بیشتر از این توان باشد، آن گاه تغییرات غیر خطی در خروجی تقویت‌کننده به فرم سیگنال‌های نوع ۳IMD یا سیگنال‌های مزاحم نوع‌های دیگر ظاهر می‌شود. یکی از روش‌های خطی کردن تقویت‌کننده‌های توان بالا، مدار تقویت‌کننده فیدفوروارد<sup>۳</sup> است که در سیستم‌های ارتباطات موبایل در استنگاه‌های زمینی به وفور استفاده می‌شود [۳] تا [۶]. این روش نسبت به مدارهای دیگر انعطاف‌پذیر است و قبل از هر چیز برای سیگنال‌های با پهنای باند زیاد مناسب است اما برای سیگنال‌های بزرگ (دامنه‌های

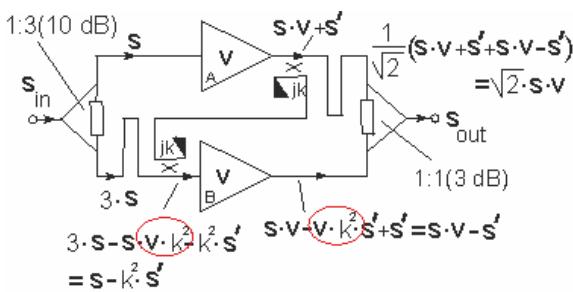


شکل ۲: اندازه‌گیری‌های تابع تبدیل تقویت‌کننده  $A$  بر حسب توان ورودی، (الف) سیگنال‌های اصلی و IMD درجهات مختلف و (ب) قدر مطلق و فاز بهره ولتاژ.

هنگامی که فرکانس سیگنال‌های ورودی یک تقویت‌کننده متعدد باشد، نوعی از سیگنال‌های مزاحم تولید شده یعنی سیگنال‌های<sup>۱</sup> ۳IMD بیش از دیگر سیگنال‌های مزاحم در خروجی مورد توجه قرار گیرند چرا که به فرکانس سیگنال‌های اصلی بسیار نزدیک هستند. آنها در محدوده پهنه‌ای باند مفید تقویت‌کننده‌ها قرار دارند و به علت محدودیت ساخت فیلترها در عمل حذف نمی‌باشند [۲]. در ایستگاه‌های زمینی، سیگنال‌های ۳IMD به وسیله تقویت‌کننده‌های توان بالا در کل باند ارسالی منتشر می‌شوند و باعث ایجاد مزاحمت و تداخل<sup>۲</sup> در باند کانال خودی و نیز کانال‌های همسایه می‌گردند. این مشکل حتی در شبکه‌های تلویزیونی نیز اتفاق می‌افتد (به وسیله سیگنال‌های ۳IMD و حتی سیگنال‌های ۲IMD)، جایی که تعداد زیادی کانال در یک فاصله فرکانسی نزدیک به هم قرار می‌گیرند.

تقویت سیگنال‌های ورودی با پوش<sup>۳</sup> ثابت مشکل ساز نیست (به عنوان مثال برای حالت سیگنال ورودی با یک فرکانس). از آنجایی که حداکثر توان پوش سیگنال ورودی برابر با توان متوسط سیگنال است، تقویت‌کننده با یک نقطه ثابت در مشخصه تابع تبدیل (محدوده خطی در

1. Third Order Intermodulation Distortion
2. Interference
3. Envelope



شکل ۵: مدار جمع‌کننده خطی با مقادیر مشخص شده سیگنال‌ها در آن.

$VK^3$  (در ورودی تقویت‌کننده  $B$ ) برابر با ۲ انتخاب شود تا سیگنال‌های اصلی ورودی دو تقویت‌کننده یکسان باشد (از آنجایی که دامنه سیگنال مزاحم  $K^2 S'$  در ورودی تقویت‌کننده  $B$  بسیار کوچک‌تر از سیگنال اصلی  $S$  است، سیگنال مزاحم تولیدشده توسط تقویت‌کننده  $B$  تقریباً برابر با سیگنال مزاحم تولیدشده توسط تقویت‌کننده  $A$  است). با مقایسه سیگنال‌ها در دو شاخه بالایی و پایینی، ضمن حذف سیگنال‌های مزاحم به وسیله جمع‌کننده، ۲ برابر توان ورودی در خروجی حاصل می‌شود.

## ۲- مدل ریاضی

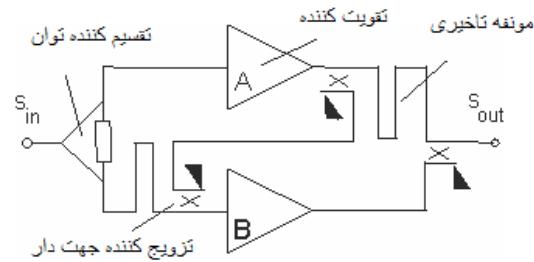
برای تشکیل مدل ریاضی تقویت‌کننده‌های توان بالا از اندازه‌گیری‌های مشخصه توابع تبدیل توان استفاده شده است. به عبارت دیگر رفتار هر تقویت‌کننده در ارتباط با  $1 \text{ dB}$  compression point و سیگنال‌های نوع  $3\text{IMD}$ ,  $5\text{IMD}$ ,  $7\text{IMD}$  و  $9\text{IMD}$  جداگانه اندازه‌گیری می‌شود. حال برای توصیف ریاضی این رفتار، ولتاژ خروجی تقویت‌کننده نسبت به ولتاژ ورودی در یک سری بسط داده می‌شود. در ابتدا از سری تیلور برای این توصیف استفاده شد که به دلیل غیر خطی بودن شدید، مدل به دست آمده متناسب با رفتارهای حقیقی تقویت‌کننده‌ها نبوده است (پیوست را بینید). در مرحله بعد از سری ولتاژ  $A$  که نسبت به سری‌های دیگر انعطاف‌پذیرتر و برای توصیف سیستم‌های غیر خطی مناسب‌تر است، استفاده شد [۹] تا [۱۱]. اندازه‌گیری‌های مشخصه توابع تبدیل توان با دو سیگنال اصلی  $^4$  و با توان‌های یکسان به عبارتی با دامنه‌های ولتاژ برابر انجام گرفته است. تفاوت اندازه‌گیری‌ها با دو سیگنال اصلی در مقایسه با یک سیگنال اصلی  $^5$  در این است که برای حالت دو سیگنال اصلی، فرکانس‌های  $3\text{IMD}$  در خروجی تقویت‌کننده‌ها در یک باند فرکانسی باریک تولید می‌شود (فرکانس‌های درجات مختلف IMD و نوع  $3\text{IMD}$  برای یک سیگنال اصلی ایجاد نمی‌شود). در محاسبات انجام شده، اثبات گردیده که اگر هر دو دامنه ولتاژ سیگنال‌های ورودی برابر باشند (همچون حالت متدالو در GSM) سری ولتاژ به سری تیلور با ثابت‌های مختلط تبدیل می‌شود [۱۲]. حال برای درست‌کردن مدل یک تقویت‌کننده با ثابت‌های مختلط باید اندازه‌گیری‌های مختلط هم در دسترس باشد، لذا از اندازه‌گیری‌های بهره تقویت‌کننده ( $S_{\text{in}} = S_{\text{out}}$ ) در محدوده اشباع نیز استفاده شده است. برای تشکیل مدل ریاضی، دو سیگنال ولتاژ سینوسی با دامنه‌های ورودی برابر  $\hat{u}_{\text{in}}$  و فرکانس‌های  $(\omega_1, \omega_2)$  در سری تیلور بسط داده می‌شود. سیگنال‌های تولیدشده شامل فرکانس‌های اصلی ورودی و تمام فرکانس‌های جدید تولیدشده در خروجی تقویت‌کننده را می‌توان در قالب

$$3. \quad k = 0.1 \quad (\text{تزویج کننده‌های جهت‌دار } -20 \text{ dB}-\text{هستند}).$$

3. Volterra Series

4. Two Tone

5. One Tone



شکل ۶: مدار تقویت‌کننده فیدفوروارد متدالو.

بزرگ در محدوده اشباع) مناسب نیست و به عبارت دیگر حذف سیگنال‌های نوع  $3\text{IMD}$  به وسیله این روش در توان‌های خروجی بالا انجام نمی‌گیرد. همچنین قابلیت خطی بالای این تکنیک با از دست دادن مقدار قابل ملاحظه بازدهی آن میسر است که تقریباً در عمل بین  $7\%$  تا  $11\%$  است [۷] و [۸]. در ارتباط با نقاط ضعف اشاره شده برای مدار فیدفوروارد متدالو، سؤال این است که آیا ممکن است سیگنال‌های مزاحم نوع  $3\text{IMD}$  در توان‌های خروجی بالا هم به مقدار قابل توجه حذف شوند و حتی برای یک دامنه ورودی مشخص (یا برای یک محدوده ورودی مشخص) صفر شوند و نیز آیا امکان افزایش بازدهی مدار وجود دارد؟ از این جهت سعی شده که ابعاد مدار فیدفوروارد متدالو را طوری تغییر دهیم که خواسته‌های بالا برآورده و نیز حذف سیگنال‌های نوع  $3\text{IMD}$  برای سیگنال‌های کوچک و هم‌زمان سیگنال‌های بزرگ را ممکن کنیم. در ارتباط با پایین‌بودن بازدهی مدار فیدفوروارد متدالو باید گفت که اولاً این مسئله به کار کرد تقویت‌کننده اصلی (تقویت‌کننده  $A$ ) که بک تقویت‌کننده کلاس  $A$  است، بر می‌گردد (شکل ۴). همچنین تقویت‌کننده کمکی (تقویت‌کننده  $B$ ) نیز کاملاً خطی است به طوری که که خود سیگنال‌های مزاحم نوع  $3\text{IMD}$  را تولید نمی‌کند و فقط سیگنال‌های سیگنال‌های تولیدشده توسط تقویت‌کننده اصلی را تقویت می‌کند. به عبارت دیگر تقویت‌کننده کمکی با وجود مصرف توان مستقیم DC برای تقویت سیگنال‌های اصلی ورودی به کار نمی‌رود. از آنجایی که تقویت‌کننده کمکی به طور ضعیف هدایت می‌شود (دامنه سیگنال‌های ورودی کوچک است) و نیز به علت کار کرد تقویت‌کننده اصلی، یک نسبت خوب حذف سیگنال‌های نوع  $3\text{IMD}$  برای دامنه‌های کوچک به دست می‌آید و به عبارت دیگر حذف سیگنال‌های نوع  $3\text{IMD}$  برای دامنه‌های بزرگ نیز تقویت می‌کند که بدین شدت کم می‌شود. در طرح جدید تقویت‌کننده کمکی علاوه بر تقویت سیگنال‌های  $3\text{IMD}$ ، سیگنال‌های اصلی را نیز تقویت می‌کند که بدین تقویت‌کننده اصلی و کمکی ( $A$  و  $B$ ) کاملاً مشابه و دارای بهره یکسان ( $V$ ) می‌باشند که بدین ترتیب جمع توان‌های سیگنال‌های اصلی در خروجی مدار ظاهر می‌شود. طرح جدید از یک طرف، توان خروجی (توان سیگنال‌های اصلی) دو تقویت‌کننده یکسان را ترکیب و از طرف دیگر سیگنال‌های خروجی را به طور قابل ملاحظه‌ای خطی می‌کند. مطابق شکل ۵ سیگنال ولتاژ ورودی  $S_{\text{in}}$  بعد از تقسیم شدن به تقویت‌کننده‌ها تزریق می‌شود با این تفاوت که خروجی تقویت‌کننده  $A$  به وسیله دو تزویج‌کننده مشابه با ثابت‌های تزویج  $j_k$  (ز نمایانگر تغییر فاز  $90^\circ$  می‌باشد) در تعذیه تقویت‌کننده  $B$  نقش ایفا می‌کند (فرض می‌شود که سیگنال‌های مزاحم تولیدشده توسط دو تقویت‌کننده در حالت ایده‌آل یکسان و برابر با  $S$  باشد). در مرحله بعدی سعی می‌شود که عبارت

۲. این فرض با شرط یکی‌بودن شرایط کاری دو تقویت‌کننده یکسان (یعنی برابر بودن سیگنال‌های ورودی آنها) تقریباً قابل تحقق است.

تقویت‌کننده توان بالا نقش مهمی را بازی می‌کنند. سیگنال‌های مزاحم تولیدشده توسط اولین ترانزیستور به وسیله عبور از ترانزیستور بعدی و ترانزیستورهای بعدی چندین بار تقویت می‌شوند و بدین وسیله سیگنال‌های نوع‌های مختلف نغییر ماهیت می‌دهند یعنی این که سیگنال‌های IMD و سیگنال‌های هارمونیک درجات بالاتر (و سیگنال‌های نوع‌های دیگر) به سیگنال‌های IMD درجات پایین‌تر از جمله سیگنال‌های ۳IMD تبدیل می‌شوند. اما بسیاری از سیگنال‌های مزاحم درجات بالاتر در تقویت‌کننده‌ای حقیقی تغییر فازهای قابل محسوس را تجربه می‌کنند به طوری که سیگنال‌های تولیدشده IMD درجات پایین‌تر، انحراف فازی بزرگی را نسبت به سیگنال‌های IMD اولیه که باید با آنها جمع شوند، نشان می‌دهند. به عبارت دیگر تبدیل‌های AM/AM و AM/PM (شکل ۱) که به طور متوالی و پشت سر هم اتفاق می‌افتد در این اختلاف نقش دارند [۱۳].

حال برای مشخص کردن ثابت‌های سری، معادلات سیستم سیگنال‌های مطرح شده به کمک مقادیر اندازه‌گیری نوشته می‌شود. معادلات سیستم برای سیگنال‌های اصلی (معادله (۲)) که از تعداد  $M$  مقادیر اندازه‌گیری متناظر  $\hat{U}_{in}$  و  $\hat{U}_{out}$  تشکیل می‌گردد، می‌تواند به صورت زیر خلاصه شود (از آنجایی که مقادیر اندازه‌گیری‌ها در سمت چپ (۲) حقیقی هست از قدر مطلق عبارات سمت راست استفاده می‌شود)

$$\begin{pmatrix} \hat{U}_{out,F,\gamma} \\ \hat{U}_{out,F,\varphi} \\ \vdots \\ \hat{U}_{out,F,M_\gamma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{U}_{in,\gamma} & \frac{9}{4}\hat{U}_{in,\gamma}^* & \dots & \left(\frac{N}{2}\right)^*\hat{U}_{in,\gamma}^* \\ \hat{U}_{in,\varphi} & \frac{9}{4}\hat{U}_{in,\varphi}^* & \dots & \left(\frac{N}{2}\right)^*\hat{U}_{in,\varphi}^* \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \hat{U}_{in,M_\gamma} & \frac{9}{4}\hat{U}_{in,M_\gamma}^* & \dots & \left(\frac{N}{2}\right)^*\hat{U}_{in,M_\gamma}^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_\gamma e^{j\varphi_\gamma} \\ c_\varphi e^{j\varphi_\varphi} \\ \vdots \\ c_{M_\gamma} e^{j\varphi_{M_\gamma}} \end{pmatrix} \quad (2)$$

معادلات سیستم برای سیگنال‌های نوع ۳IMD نیز مشابه معادلات سیگنال‌های اصلی و بر اساس (۳) برای  $M_\gamma$  مقادیر اندازه‌گیری می‌تواند به صورت (۸) خلاصه گردد که معادلات سیستم سیگنال‌های IMD درجات بالاتر نیز به طریق مشابه به دست می‌آیند.

برای نوشتن معادلات سیستم مربوط به بهره تقویت‌کننده، سیگنال ولتاژ خروجی بر حسب ولتاژ ورودی با دامنه  $\hat{U}_{in}$  و فرکانس  $f(\omega)$  در سری تیلور بسط داده می‌شود. عبارت ولتاژ خروجی برای فرکانس اصلی را می‌توان به صورت (۹) خلاصه کرد

$$u_{out}(t) = \sum_{m=1}^{N-1} \left\{ \sum_{n=m}^{N-1} \binom{2n+1}{n} \binom{2n+1}{n-m} \frac{\hat{U}_{in}^{2n+1}}{2^{rn}} c_{n+1} \cos((m+1)\omega_r - m\omega_r)t \right\} + \sum_{m=1}^{N-1} (t) \left\{ \sum_{n=m}^{N-1} \binom{2n+1}{n} \binom{2n+1}{n-m} \frac{\hat{U}_{in}^{2n+1}}{2^{rn}} c_{n+1} \cos(((m+1)\omega_r - m\omega_r)t) \right\} \quad (1)$$

یک فرم کلی به صورت (۱) خلاصه کرد [۱۲] و در آن  $N$  حداکثر درجه سری تیلور،  $n$  اندیس متغیر،  $m$  درجه سیگنال‌های IMD تولیدشده (عدد صحیح) و  $c_n$  ثابت‌های سری تیلور (عدد صحیح) است که سهم سیگنال‌های اصلی (یا فرکانس‌های اصلی) و سیگنال‌های IMD درجات مختلف (۳ تا ۹) به صورت زیر است

$$\hat{U}_{out,F} = \sum_{n=1}^{N-1} \binom{2n+1}{n} \binom{2n+1}{n} \frac{\hat{U}_{in}^{2n+1}}{2^{rn}} c_{n+1} \quad (2)$$

$$\hat{U}_{out,\gamma IMD} = \sum_{n=1}^{N-1} \binom{2n+1}{n} \binom{2n+1}{n-1} \frac{\hat{U}_{in}^{2n+1}}{2^{rn}} c_{n+1} \quad (3)$$

$$\hat{U}_{out,\varphi IMD} = \sum_{n=1}^{N-1} \binom{2n+1}{n} \binom{2n+1}{n-2} \frac{\hat{U}_{in}^{2n+1}}{2^{rn}} c_{n+1} \quad (4)$$

$$\hat{U}_{out,\gamma IMD} = \sum_{n=1}^{N-1} \binom{2n+1}{n} \binom{2n+1}{n-3} \frac{\hat{U}_{in}^{2n+1}}{2^{rn}} c_{n+1} \quad (5)$$

$$\hat{U}_{out,\varphi IMD} = \sum_{n=1}^{N-1} \binom{2n+1}{n} \binom{2n+1}{n-4} \frac{\hat{U}_{in}^{2n+1}}{2^{rn}} c_{n+1} \quad (6)$$

همان گونه که در (۲) تا (۶) می‌بینیم، فقط ثابت‌های فرد ( $c_{n+1}$ ) در سری ظاهر شده‌اند چرا که فقط این ثابت‌ها در تعیین سیگنال‌های IMD مورد نظر (۳IMD، ۵IMD، ...) و در پهنای باند (میان گذر) ما قرار دارند (سیگنال‌های با ثابت‌های زوج در خارج از این پهنای باند قرار دارند). علاوه بر این، دامنه سیگنال‌های IMD درجات زوج (۴IMD، ۶IMD، ...) در تقویت‌کننده‌ها تقریباً کوچک هست چرا که تابع تبدیل تقویت‌کننده فرد است (شکل ۱-الف).

لازم به ذکر است که مدل ریاضی تقویت‌کننده‌های توان بالا وقتی دقیق‌تر می‌شود که سیگنال‌های IMD درجات مختلف بیشتری را بر حسب توان ورودی توصیف کنیم و نیز وقتی که ثابت‌های بیشتری را در سری انتخاب کنیم. اما باید توجه کرد که با افزایش دامنه سیگنال‌های ورودی، دقت ثابت‌های درجات بزرگ‌تر نسبت به درجات کوچک‌تر کمتر می‌شود که این خود منجر به تشکیل یک مدل با دقت کمتر می‌گردد. با مشخص شدن ثابت‌های سری می‌توان چندجمله‌ای‌های به دست آمده را به عنوان مدل ریاضی تقویت‌کننده معرفی کرد.

در شکل‌های ۲ و ۳ نتایج اندازه‌گیری‌ها برای سیگنال‌های اصلی و سیگنال‌های IMD درجات مختلف (برای حالت two tone) و مقادیر قدر مطلق و فاز بهره ولتاژ (برای حالت one tone) دو تقویت‌کننده بر حسب توان ورودی نشان داده شده است. همان گونه در شکل‌های ۲ و ۳ می‌بینیم با وجود این که هر دو تقویت‌کننده کاملاً یکسان هستند، منحنی‌های متناسب آنها یکی نیست. از طرف دیگر اختلاف اندازه سیگنال‌های IMD درجات یکسان (دو سیگنال IMD قرارگرفته در دو طرف سیگنال‌های اصلی) هر تقویت‌کننده علی‌الخصوص برای دامنه‌های بزرگ قابل روئیت است (علی‌رغم یکسان‌بودن آنها در تئوری). برای تجزیه و تحلیل این اختلاف، ترانزیستورهای غیر خطی تشکیل‌دهنده

اندازه‌گیری هر سیگنال انتخاب می‌شود.

### ۳- بهینه‌سازی

در این قسمت سعی می‌شود که مشخصه توابع تبدیل توان و بهره تقویت‌کننده به صورت یک مدل در قالب مسئله تقریب ریاضی آورده شود، به عبارت دیگر مدلی جستجو می‌شود که به رفتار اندازه‌گیری‌های عملی تا حد امکان نزدیک باشد. برای این کار از روش بهینه‌سازی به طریق عددی استفاده می‌شود به این معنی که به کمک مشخص کردن ثابت‌های مدل، اختلاف بین مدل و اندازه‌گیری‌ها را کمینه می‌کنیم. برای بهینه‌سازی از روش حداقل مربعات (Least Square Method) استفاده می‌شود که ثابت‌های مدل را از طریق صفر کردن مشتقات جزیی مشخص می‌کند [۱۴] یعنی

$$e = \sum_{i=1}^n g_i (|y_m(\underline{C}) - y_i|^\gamma) \quad (14)$$

و برای رابطه فازی

$$e = \sum_{i=1}^n g_i (\angle y_m(\underline{C}) - \varphi_i) \quad (15)$$

که  $e$  تابع خط،  $y_i$  مقادیر خروجی اندازه‌گیری شده،  $y_m$  مقادیر خروجی مدل،  $\varphi_i$  مقادیر خروجی اندازه‌گیری شده برای فاز بهره،  $g_i$  تابع وزنی،  $n$  تعداد مقادیر اندازه‌گیری‌ها است. معادل (۱۴) و (۱۵) برای حالت برداری (Euclidean Norm) برابر است با

$$\min(g_i |y_m(\underline{C}) - y_i|^\gamma) \quad (16)$$

که در حالت ماتریسی به رابطه زیر تبدیل می‌شود

$$\begin{aligned} \min \left( g_i \left\| \begin{pmatrix} y_{1,1} & y_{1,2} & \cdots & y_{1,N} \\ y_{2,1} & y_{2,2} & \cdots & y_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{M,1} & y_{M,2} & \cdots & y_{M,N} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{C}_1 \\ \vdots \\ \underline{C}_{\gamma} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_M \end{pmatrix} \right\|^{\gamma} \right) \\ = \min(g_i |AC - b|^\gamma) \end{aligned} \quad (17)$$

که در آن  $A$  ماتریس اصلی و  $b$  بردار خروجی متناسب است. طبیعی است که برای معادلات سیستم بزرگ (رابطه (۱۳)) باید همه سیگنال‌های خروجی مورد بحث ملاحظه شوند. به این دلیل تابع ارزش Function (به عنوان تابع خطای کل، که جمع جدایانه همه تابع‌ها (تابع خط) را شامل می‌شود تشکیل می‌گردد. برای ۶ سیگنال خروجی (۱۸) را داریم

$$\hat{u}_{out,G} = c_1 \hat{u}_{in} + \frac{3}{4} c_2 \hat{u}_{in}^\gamma + \frac{1}{16} c_3 \hat{u}_{in}^{\delta} + \dots + \left( \frac{N}{N-1} \right) \frac{\hat{u}_{in}^N}{2^{N-1}} \quad (9)$$

در انتقال به ثابت‌های مختلط  $C_N$  می‌تواند در سری تیلور مختلط به صورت زیر نوشته شود

$$U_{out,F} =$$

$$C_1 \hat{u}_{in} + \frac{3}{4} C_2 \hat{u}_{in}^\gamma + \frac{1}{16} C_3 \hat{u}_{in}^{\delta} + \dots + \left( \frac{N}{N-1} \right) \frac{\hat{u}_{in}^N}{2^{N-1}} C_N \quad (10)$$

یا برای بهره مختلط  $\underline{v} = \underline{S}_{\gamma}$  داریم

$$\underline{v} = \frac{U_{out,F}}{\hat{u}_{in}} =$$

$$C_1 + \frac{3}{4} C_2 \hat{u}_{in}^\gamma + \frac{1}{16} C_3 \hat{u}_{in}^{\delta} + \dots + \left( \frac{N}{N-1} \right) \frac{\hat{u}_{in}^{N-1}}{2^{N-1}} C_N \quad (11)$$

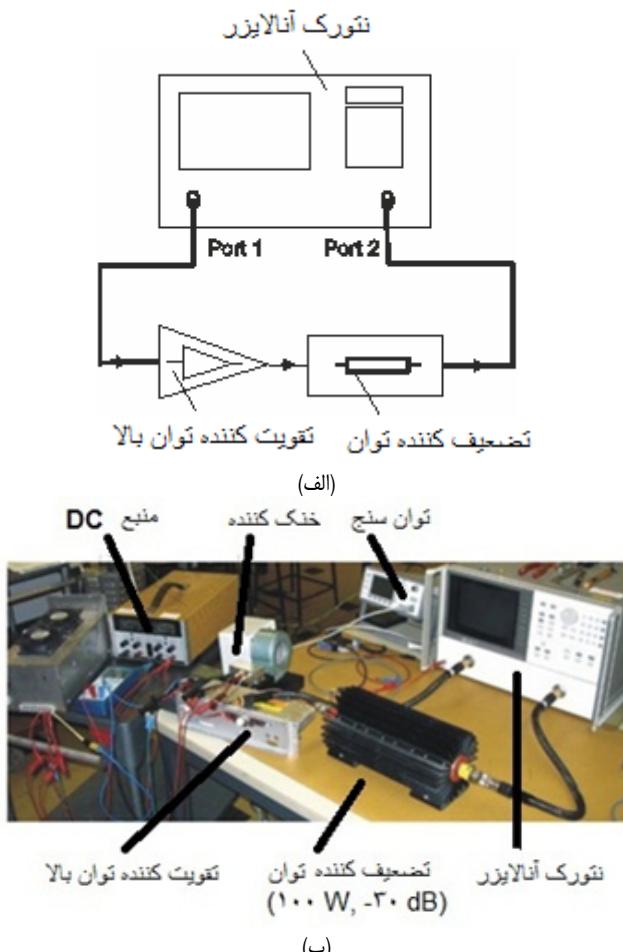
معادلات سیستم بهره تقویت‌کننده برای  $M$  مقادیر اندازه‌گیری عبارت است از

$$\begin{pmatrix} \underline{v}_1 \\ \underline{v}_2 \\ \vdots \\ \underline{v}_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{4} \hat{u}_{in,1}^\gamma & \cdots & \left( \frac{N}{N-1} \right) \frac{\hat{u}_{in,M}^{N-1}}{2^{N-1}} \\ 1 & \frac{3}{4} \hat{u}_{in,2}^\gamma & \cdots & \left( \frac{N}{N-1} \right) \frac{\hat{u}_{in,M,2}^{N-1}}{2^{N-1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \frac{3}{4} \hat{u}_{in,M}^\gamma & \cdots & \left( \frac{N}{N-1} \right) \frac{\hat{u}_{in,M}^{N-1}}{2^{N-1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_N \end{pmatrix} \quad (12)$$

حال باید قدر مطلق و فاز بهره تقویت‌کننده ( $|S_{\gamma}| = |\underline{v}|$ ) به طور جداگانه به عنوان مقادیر حقیقی در نظر گرفته شود. از آنجایی که ثابت‌های سری تیلور باید در همه معادلات سیستم صدق کنند و به عبارت دیگر چون همه معادلات سیستم باید هم‌زمان حل شوند، می‌توانیم همه معادلات سیستم به دست آمده را در یک معادلات سیستم بزرگ خلاصه کنیم (رابطه (۱۳)). توجه شود که سری تیلور تا درجه ۱۳ انتخاب شده است و بدین ترتیب معادلات سیستم خطی حاصل می‌شود که به تعداد مقادیر اندازه‌گیری‌ها ( $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$ ) بستگی دارد. توجه شود که تعداد مقادیر اندازه‌گیری‌ها یکسان نیست و بر حسب طول قابل

$$\begin{pmatrix} \hat{u}_{out,\gamma IMD,1} \\ \hat{u}_{out,\gamma IMD,2} \\ \vdots \\ \hat{u}_{out,\gamma IMD,M_{\gamma}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \hat{u}_{in,1}^\gamma & \frac{5}{16} \hat{u}_{in,1}^{\delta} & \cdots & \left( \frac{N}{N-1} \right) \left( \frac{N}{N-3} \right) \frac{\hat{u}_{in,M_{\gamma}}^N}{2^{N-1}} \\ \frac{3}{4} \hat{u}_{in,2}^\gamma & \frac{5}{16} \hat{u}_{in,2}^{\delta} & \cdots & \left( \frac{N}{N-1} \right) \left( \frac{N}{N-3} \right) \frac{\hat{u}_{in,M_{\gamma},2}^N}{2^{N-1}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{3}{4} \hat{u}_{in,M_{\gamma}}^\gamma & \frac{5}{16} \hat{u}_{in,M_{\gamma}}^{\delta} & \cdots & \left( \frac{N}{N-1} \right) \left( \frac{N}{N-3} \right) \frac{\hat{u}_{in,M_{\gamma}}^N}{2^{N-1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 e^{j\varphi_{c_1}} \\ c_2 e^{j\varphi_{c_2}} \\ \vdots \\ c_N e^{j\varphi_{c_N}} \end{pmatrix} \quad (8)$$

$$\begin{aligned}
 & \left( \begin{array}{ccccc}
 \hat{u}_{in,\gamma} & \frac{\gamma}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{1+\epsilon}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \dots & \frac{184+41}{256} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{in,\gamma} & \frac{\gamma}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{1+\epsilon}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \dots & \frac{184+41}{256} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \hat{u}_{in,M\gamma} & \frac{\gamma}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \frac{1+\epsilon}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \dots & \frac{184+41}{256} \hat{u}_{in,M\gamma}^* \\
 \cdot & \frac{\gamma}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{5\epsilon}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \dots & \frac{552+123}{1024} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \cdot & \frac{\gamma}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{5\epsilon}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \dots & \frac{552+123}{1024} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \hat{u}_{out,G,\gamma} & \cdot & \frac{\gamma}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \frac{5\epsilon}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \dots & \frac{552+123}{1024} \hat{u}_{in,M\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,G,\gamma} & \cdot & \frac{\gamma}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \frac{5\epsilon}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \dots & \frac{552+123}{1024} \hat{u}_{in,M\gamma}^* \\
 \vdots & & & & & \\
 \hat{u}_{out,G,M\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \dots & \frac{3+6735}{1024} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \dots & \frac{3+6735}{1024} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,M\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \dots & \frac{3+6735}{1024} \hat{u}_{in,M\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{3\delta}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \dots & \frac{61347}{512} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,M\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{3\delta}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \dots & \frac{61347}{512} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,M\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{3\delta}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \dots & \frac{61347}{512} \hat{u}_{in,M\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{12\epsilon}{256} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{2541}{512} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{18731}{\lambda} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{12\epsilon}{256} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{2541}{512} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{18731}{\lambda} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,M\gamma} & \cdot & \cdot & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{12\epsilon}{256} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \frac{2541}{512} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \frac{18731}{\lambda} \hat{u}_{in,M\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{1716}{2} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{1716}{2} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{1716}{2} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{1716}{2} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{1716}{2} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \vdots & \ddots & \vdots \\
 \hat{u}_{out,\gamma IMD,\gamma} & \cdot & \cdot & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,M\gamma}^* & \frac{1}{\epsilon} \hat{u}_{in,\gamma}^* & \frac{1716}{2} \hat{u}_{in,\gamma}^* \\
 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c}
 c_c e^{j\varphi_{c\gamma}} \\
 c_c e^{j\varphi_{c\gamma}} \\
 c_s e^{j\varphi_{cs}} \\
 c_s e^{j\varphi_{cs}} \\
 c_v e^{j\varphi_{cv}} \\
 c_v e^{j\varphi_{cv}} \\
 c_{\alpha} e^{j\varphi_{c\alpha}} \\
 c_{\alpha} e^{j\varphi_{c\alpha}} \\
 c_{\beta} e^{j\varphi_{c\beta}} \\
 c_{\beta} e^{j\varphi_{c\beta}} \\
 c_{\gamma} e^{j\varphi_{c\gamma}} \\
 c_{\gamma} e^{j\varphi_{c\gamma}} \\
 c_{\delta} e^{j\varphi_{c\delta}} \\
 c_{\delta} e^{j\varphi_{c\delta}} \\
 c_{\epsilon} e^{j\varphi_{c\epsilon}} \\
 c_{\epsilon} e^{j\varphi_{c\epsilon}} \\
 c_{\eta} e^{j\varphi_{c\eta}} \\
 c_{\eta} e^{j\varphi_{c\eta}} \\
 c_{\tau} e^{j\varphi_{c\tau}} \\
 c_{\tau} e^{j\varphi_{c\tau}}
 \end{array} \right) \quad (13)
 \end{aligned}$$

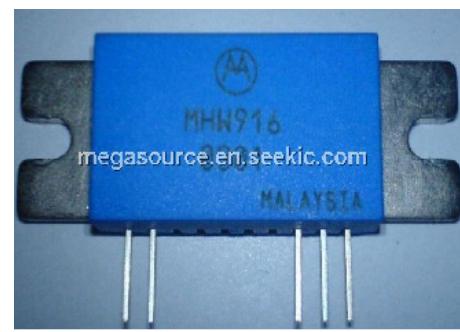


شکل ۸: نحوه اندازه‌گیری‌های عملی مشخصه قدر مطلق و فاز بهره تقویت‌کننده‌ها،  
(الف) نحوه نصب و (ب) مدار اندازه‌گیری شده.

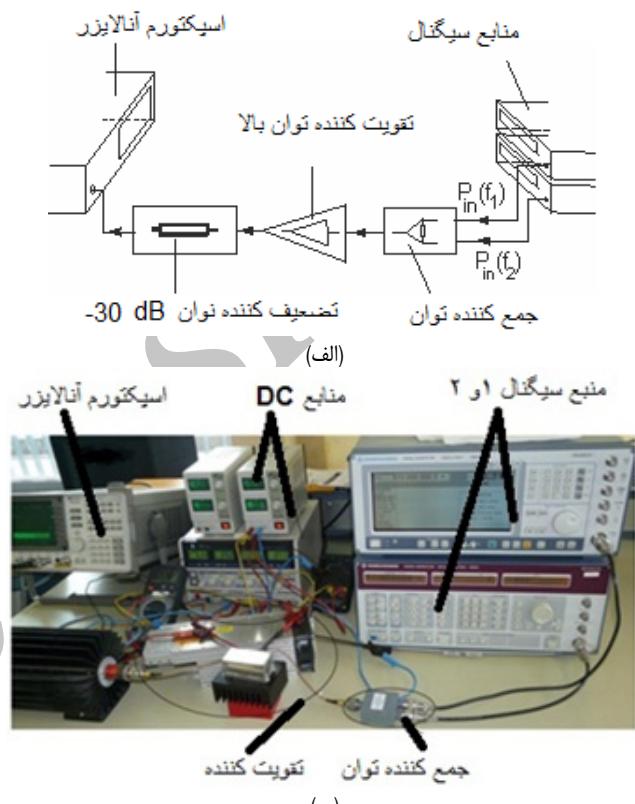
فاز بهره تقویت‌کننده بهتر از سیگنال‌های دیگر به مقادیر اندازه‌گیری نزدیک‌تر شوند، به عبارت دیگر فاکتورهای وزنی  $G_1$ ،  $G_2$ ،  $G_3$  و  $G_4$  نسبت به وزن‌های دیگر بزرگ‌تر انتخاب شده‌اند.

#### ۴- مقایسه نتایج تئوری و عملی

در این قسمت ابتدا نحوه اندازه‌گیری عملی تقویت‌کننده‌ها توضیح داده شده و سپس مقایسه‌ای بین مقادیر اندازه‌گیری‌ها و مدل حاصل انجام خواهد گرفت. برای اندازه‌گیری‌های مشخصه توان، سیگنال‌های دو منبع سینوسی با فرکانس‌های  $f_1 = 910 \text{ MHz}$  و  $f_2 = 911 \text{ MHz}$  (فرکانس‌های محدوده کار GSM) به وسیله تزویج‌کننده جهت دار +3 dB (Wilkinson) ترکیب و به تقویت‌کننده‌ها تزریق شده و سپس توان‌های خروجی در حوزه فرکانس به کمک اسپکتروم آنالایزر HP8565E رسم شده‌اند (شکل‌های ۲ و ۳). برای اندازه‌گیری بهره مختلط تقویت‌کننده‌ها در محدوده اشباع نیز دو سر ورودی و خروجی تقویت‌کننده به پورت‌های نورک آنالایزر HP8722C متصل می‌شود. از آنجایی که توان ورودی قابل تحمل برای آنالایزر محدود است از یک تضعیف‌کننده در ورودی آن استفاده شده است (به مقادیر بهره در شکل‌های ۲ و ۳ باید ۳۲ dB اضافه شود). تقویت‌کننده‌های استفاده شده در مدار، مدل MHW916 (سیلیسیم، FET) هستند که از اتصال سری چندین تقویت‌کننده کوچک‌تر با توان IMD درجهات بالاتر در دامنه‌های بزرگ‌تر مشکل‌تر است. به این دلیل در (۱۹) فاکتورهای وزنی مختلف طوری انتخاب شده‌اند که سیگنال‌های مهم یعنی سیگنال‌های اصلی و ۳IMD و قدر مطلق و



شکل ۹: تقویت‌کننده توان استفاده شده در تست‌های عملی.



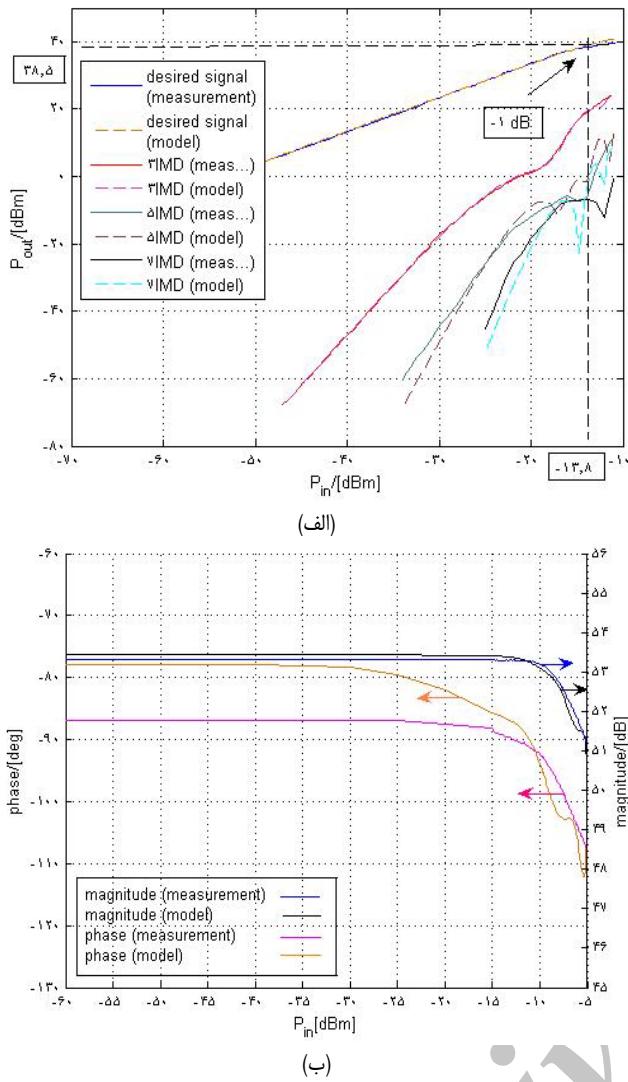
شکل ۷: نحوه اندازه‌گیری‌های عملی مشخصه تابع تبدیل توان تقویت‌کننده‌ها، (الف)  
نحوه نصب و (ب) مدار اندازه‌گیری شده.

$$e_{Sum} = e_1 + e_2 + e_3 + e_4 + e_5 + e_6 = \sum_{i=1}^n g_i (|y_{1,m}(C)| - y_{i1})^r + \dots + \sum_{i=1}^n g_i (|y_{5,m}(C)| - y_{i5})^r \quad (18)$$

لازم به ذکر است که در تابع خطای کل بهتر آن است از فاکتورهای وزنی ( $G_1$ ،  $G_2$ ، ...). علاوه بر توابع وزنی ( $g_1$ ،  $g_2$ ، ... ...) برای هر سیگنال خروجی استفاده شود تا این که بتوان سیگنال خروجی یا سیگنال‌های خروجی را با تغییرات این وزن‌ها بر حسب نیاز بهینه کرد. بنابراین (۱۸) در شکل جدید به صوت زیر نوشته می‌شود

$$e'_{Sum} = G_1 \times e_1 + G_2 \times e_2 + G_3 \times e_3 + G_4 \times e_4 + G_5 \times e_5 + G_6 \times e_6 \quad (19)$$

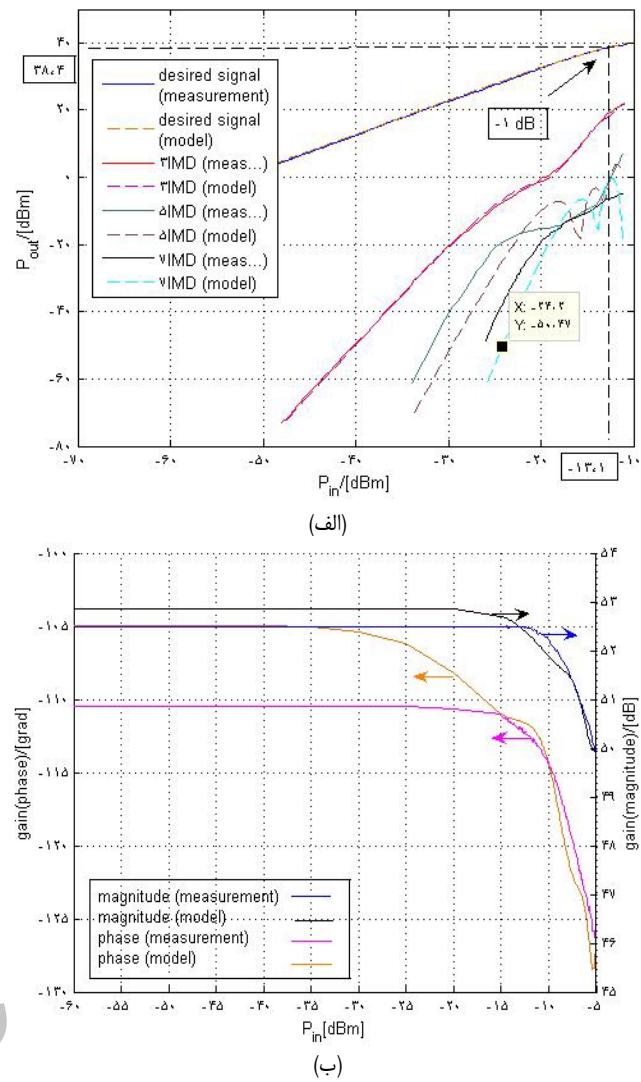
بررسی‌ها نشان می‌هد که همه ثابت‌های مدل (ثابت‌های سری) به دست آمده را نمی‌توان با خطاهای کوچک تعیین کرد [۱۲] به ویژه انطباق سیگنال‌های IMD درجهات بالاتر در دامنه‌های بزرگ‌تر مشکل‌تر است. به این دلیل در (۱۹) فاکتورهای وزنی مختلف طوری انتخاب شده‌اند که سیگنال‌های مهم یعنی سیگنال‌های اصلی و ۳IMD و قدر مطلق و



شکل ۱۰: مقایسه مدل و اندازه‌گیری‌های تابع تبدیل تقویت‌کننده  $B$ . (الف) سیگنال‌های اصلی و IMD درجهات مختلف و (ب) قدر مطلق و فاز بهره و لتأثر.

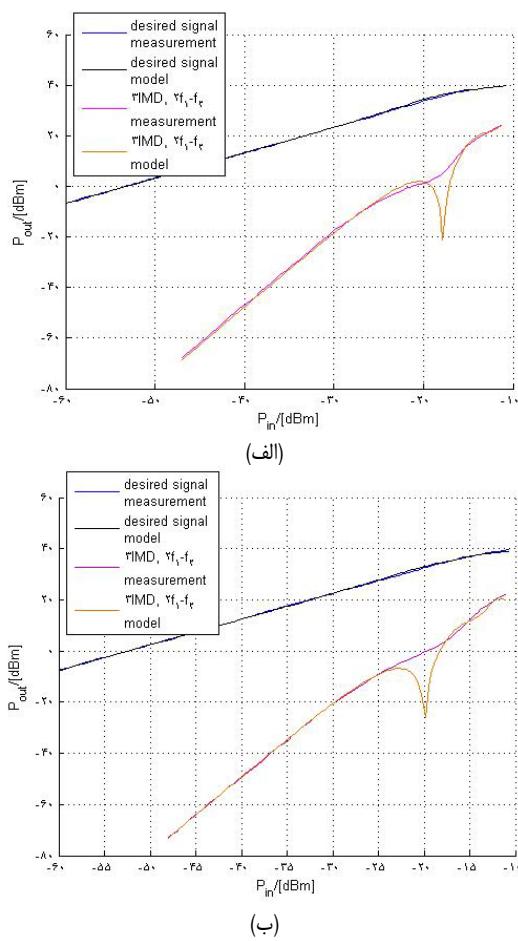
بهترین مدل ممکن، مقادیر مختلف  $N$  امتحان شده است. با افزایش  $N$  بهترین مدل اندازه‌گیری‌ها و مدل بیشتر به هم نزدیک می‌شوند اما برای مقادیر بزرگ‌تر از ۱۳ مدل بهتر نمی‌شود. مدل‌های دو تقویت‌کننده برای ورودی‌های با دامنه‌های بزرگ‌تر (محدوده کاملاً اشباع غیر خطی) نیز بررسی شده که نتایج به دست آمده رضایت‌بخش نبوده است [۱۲]. در شبیه‌سازی مدار مشخص شده که تعداد سیگنال‌های خروجی تقویت‌کننده  $A$  (همه سیگنال‌های تولیدشده نوع‌های مختلف) حدود ۹۸ سیگنال می‌باشد. با این حجم زیاد سیگنال، به کار بردن یک روش تحلیلی برای تقویت‌کننده  $B$  غیر منطقی است و به عبارت دیگر محاسبه سیگنال‌های خروجی تقویت‌کننده  $B$  برای این حجم سیگنال در حوزه زمان یا در حوزه فرکانس به علت طولانی بودن زمان محاسبات غیر عملی است. بدین جهت از روش گستته عددی (به کمک DFT) در MATLAB استفاده شده که نسبت به نرم‌افزارهای دیگر منعطف‌تر است. برنامه‌های شبیه‌سازی دیگر همچون ADS<sup>۱</sup> و AWR<sup>۲</sup>، محدودیت‌هایی برای مدل نشان داده‌اند.

1. Discrete Fourier Transform
2. Advance Design System
3. Advancing the Wireless Revolution



شکل ۹: مقایسه مدل و اندازه‌گیری‌های تابع تبدیل تقویت‌کننده  $A$ . (الف) سیگنال‌های اصلی و IMD درجهات مختلف و (ب) قدر مطلق و فاز بهره و لتأثر.

در شکل‌های ۹ و ۱۰ مقادیر اندازه‌گیری و مدل دو تقویت‌کننده برای مشخصه توابع تبدیل توان و بهره (قدر مطلق و فاز) مقایسه شده‌اند (به علت کاهش خطأ، از سیگنال‌های IMD<sup>۳</sup> در مدل نهایی صرف نظر شده است) و مقادیر عددی ثابت‌ها در پیوست آمده است. در شکل‌های ۹-ب و ۱۰-ب یک تطبیق خوب برای قدر مطلق و فاز بهره هر دو تقویت‌کننده مشاهده می‌شود. خطای به دست آمده برای فاز فقط در حدود چند درجه و برای قدر مطلق حدوداً ۰.۵ dB است. همچنین مشاهده می‌شود منحنی‌های سیگنال‌های اصلی و IMD<sup>۳</sup> در مشخصه توابع تبدیل توان از یک تطبیق بسیار خوب برخوردارند. برای سیگنال‌های IMD<sup>۵</sup> و IMD<sup>7</sup> با افزایش دامنه ورودی، عدم انتباطی بین مقادیر اندازه‌گیری‌ها و مدل با نوسان ملایم ظاهر می‌شود (باید توجه کرد که برای تطبیق بهتر سیگنال‌های اصلی و IMD<sup>3</sup> و مهم‌تر بودن این سیگنال‌ها ثابت‌های وزنی آنها بزرگ‌تر انتخاب شده‌اند). دقت مدل به دست آمده قبل از هر چیز به محدوده دامنه سیگنال‌های ورودی بستگی دارد. هرچه به محدوده اشباع نزدیک‌تر می‌شویم دقت مدل کمتر می‌شود که دلیل اصلی آن به نقش ثابت‌های با درجهات بالاتر برمی‌گردد. پس از یک طرف با افزایش مؤلفه‌های درجهات بالاتر در سری، مدل بیشتر به مقادیر اندازه‌گیری نزدیک می‌شود و از طرف دیگر خطای تقریب در نزدیک مرزهای محدوده تقریب، بیشتر و در منطقه فراتر از آن، مدل واگرا می‌شود. برای حصول

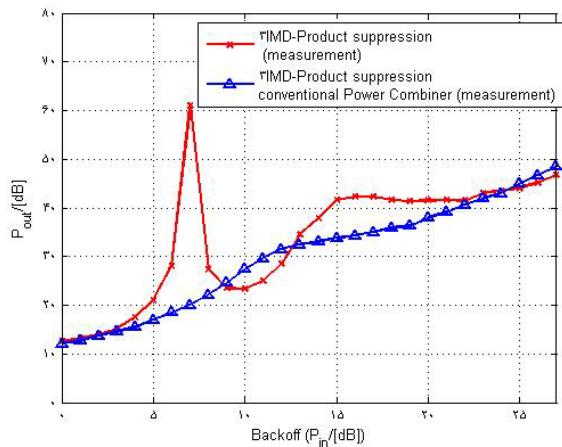


شکل پ-۱: مقایسه مدل و اندازه‌گیری‌های تابع تبدیل تقویت‌کننده‌ها برای سیگنال‌های اصلی و سیگنال‌های  $\text{IMD}^3$ . (الف) تقویت‌کننده A و (ب) تقویت‌کننده B.

تقویت‌کننده توان بالا از اندازه‌گیری‌های سیگنال‌های اصلی و سیگنال‌های  $\text{IMD}$  در درجات مختلف بر حسب توان ورودی و نیز از اندازه‌گیری‌های بهره مختلط تقویت‌کننده در محدوده اشباع استفاده شده و اساساً ما می‌توانستیم هر کدام از اندازه‌گیری‌ها را با یک سری تیلور جداگانه توصیف کنیم که یک تقریب بسیار خوب نیز حاصل می‌شد. اما هیچ کدام از ثابت‌هایی به دست آمده برای کل مدل تقویت‌کننده (یعنی همه منحنی‌ها به طور همزمان) مناسب نمی‌بود. بدین جهت فقط از یک سری تیلور برای مدل کردن تقویت‌کننده استفاده شد که همه ثابت‌ها به طور همزمان در همه منحنی‌ها صدق کند. برای درست کردن مدلی واقعی‌تر که نمایانگر رفتار حقیقی تقویت‌کننده‌های توان بالا باشد، از ثابت‌های درجات بالاتر در سری استفاده شده است (اندازه‌گیری‌های سیگنال‌های  $\text{IMD}$  در درجات بالا نیز مکمل تعیین دقیق‌تر ثابت‌های سری است) اما با توجه به بزرگ‌تر شدن مقادیر عددی ثابت‌ها، خطای حاصل برای دامنه‌های بزرگ‌تر بیشتر می‌شود. مناسب‌تر است برای پایداری بیشتر در مقابل تغییرات دما و مقابله با کهنه‌گی از مدارهای مجتمع برای دو تقویت‌کننده، بطور جداگانه استفاده شود. در کارهای عملی، تغییرات دامنه ورودی و نیز تغییرات شکل سیگنال و تغییرات دما در مدار باید کنترل شود. این کار با استفاده از تضییف‌کننده متغیر و تغییردهنده فاز کنترل شده با میکروپروسسورها و سنسورهای حساس در ورودی تقویت‌کننده‌ها انجام می‌گیرد همان‌گونه که از مدار فیدفوروارد محدود می‌شناشیم.

## پیوست

(الف) در شکل پ-۱ مدل‌های دو تقویت‌کننده بر اساس سری تیلور (با



شکل ۱۱: مقایسه منحنی Backoff (بر حسب توان ورودی) مدار جمع‌کننده جدید با مدار جمع‌کننده محدود در تحت فشار گذاشتن سیگنال  $\text{IMD}^3$ .

برای اثبات کارکرد عملی مدار، یک نمونه آزمایشگاهی ساخته و اندازه‌گیری شده است. نتایج مدار جمع‌کننده جدید با مدار جمع‌کننده محدود (با دو تقویت‌کننده نوع A در حالت موزایی) و در شرایط یکسان (یعنی توان ورودی یکسان) برای حالت Backoff (یعنی بازگشت از توان‌های ورودی بزرگ کاملاً غیر خطی به توان‌های ورودی کوچک برای کاهش سیگنال‌های مزاحم) در اینجا  $\text{IMD}^3$  در شکل ۱۱ می‌باشد. همان‌طور که دیده می‌شود، مدار جمع‌کننده جدید در مقایسه با مدار جمع‌کننده محدود در یک گستره قابل توجهی (در محدوده اشباع) سیگنال‌های  $\text{IMD}^3$  را تحت فشار قرار می‌دهد و به عبارت دیگر مدار در این گستره خطی شده است.

اما حذف سیگنال‌های  $\text{IMD}^3$  به یک رنج محدودی از دامنه ورودی محدود شده و دامنه سیگنال‌های  $\text{IMD}^3$  در مقایسه با مدار جمع‌کننده محدود در خارج از این رنج بهتر نشده است. برای کاربردهای عملی این این امر دور از انتظار نیست چرا که مدار فقط برای همین دامنه ورودی محدود تنظیم شده است. این بدان معنی است که برای گستره بزرگ تغییرات دامنه ورودی (مقادیر دامنه‌های کوچک تا بزرگ)، حلقه‌های تشکیل‌دهنده مدار نیز متناسبًا باید تنظیم شوند. باید توجه کرد در مواردی که فقط تغییرات جزئی دامنه ورودی مد نظر است مثل تقویت‌کننده‌های مورد استفاده در ماهواره‌های تلویزیونی، خطی شدن (یعنی همان حذف سیگنال‌های  $\text{IMD}^3$ ) به وسیله مدار جدید در مقایسه با مدار جمع‌کننده محدود به طور محسوسی بهبود یافته است.

در نمونه عملی آزمایش شده، بازدهی مدار حدود ۳۶٪ اندازه‌گیری شده است که حاکی از افزایش ۳ برابری در مقایسه با مدار فیدفوروارد محدود است. در انتهای برای ارزیابی دقیق‌تر از نتایج به دست آمده، روش ارائه شده در این مقاله با روش‌های دیگر خطی‌سازی در جدول ۱ مقایسه شده است.

## ۵- نتیجه‌گیری

مقاله ارائه شده تحقیقی برای ادغام مدارهای جمع‌کننده محدود و تقویت‌کننده فیدفوروارد محدود است چرا که ترکیب جمع توان‌های دو تقویت‌کننده (در جمع‌کننده‌های محدود) با حذف هم‌زمان سیگنال‌های  $\text{IMD}^3$  در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای توصیف ریاضی کل مدار، هر تقویت‌کننده توان بالا جداگانه تحلیل شد و به عبارت دیگر مدل ریاضی هر تقویت‌کننده تشکیل گردید. توصیف المان‌های دیگر مدار به عنوان مدل ریاضی به سادگی انجام می‌گیرد چرا که رفتار آنها در محدوده تقطه کار مورد نظر کاملاً خطی است. برای تعیین مدل یک

جدول ۱: مقایسه روش‌های خطی‌سازی با هم‌دیگر.

پهنه‌ای باند	پایداری	بازدهی	خطی‌سازی
محدود	محدودیت در فرکانس‌های بالا	پایین	محدودیت کاهش سیگنال‌های ۳IMD (محدودیت خطی‌سازی)
مناسب	پایداری بدون پیش‌شرط	نسبتاً بالا	محدودیت کاهش سیگنال‌های ۳IMD (محدودیت خطی‌سازی)
مناسب	پایداری بدون پیش‌شرط	پایین	مناسب (برای دامنه‌های کوچک)
مناسب	پایداری بدون پیش‌شرط	بالا	مناسب (برای دامنه‌های بزرگ)

- [2] K. Solbach, *Feed Forward Amplifier for GSM*, University Duisburg-Essen, Germany, Sep. 2002.
- [3] H. S. Black, *Wave Translation System*, USA Patent, US2,102,671, Dec. 1937.
- [4] N. Pothecary, *Feedforward Linear Power Amplifier*, Artech House, 1999.
- [5] P. B. Kenington, *High-Linearity RF Amplifier Design*, Artech House, 2000.
- [6] J. Eisenberg, L. Altos, and S. Avis, *Closed Loop Active Cancellation Technique (ACT)-Based RF Power Architecture*, USA Patent, US 6,452,446 B1, Sep. 2002.
- [7] K. J. Cho, J. H. Kim, and S. P. Stapleton, "RF high power doherty amplifier for improving the efficiency of a feed forward linear amplifier," *IEEE MTT-S Int. Microwave Symposium Digest*, vol. 2, pp. 847-850, Seoul, South Korea, Jul. 2004.
- [8] T. Ogawa, T. Iwasaki, H. Maruyama, K. Horiguchi, M. Nakayama, Y. Ikeda, and H. Kurebayashi, "High efficiency feed-forward amplifier using RF predistortion linearizer and the modified doherty amplifier," *IEEE MTT-S Int. Microwave Symposium Digest*, vol. 2, pp. 537-540, Tokyo, Japan, 6-11 Jun. 2004.
- [9] E. Chong, *The Volterra Series and the Direct Method of Distortion Analysis*, University of Toronto, Research Work, 2001.
- [10] J. Vuolevi and T. Rahkonen, *Distortion in RF Power Amplifier*, Artech House, 2003.
- [11] J. Aikio, *Frequency Domain Model Fitting and Volterra Analysis Implemented on top of Harmonic Balance Simulation*, Faculty of Technology, Department of Electrical and Information Engineering, University of Oulu, Research Work, 2007.
- [12] M. R. Motavalli, *Untersuchung einer Leistungskombinations-Schaltung mit Feed Forward-Linearisierung*, Dissertation, University Duisburg-Essen, Germany, Sep. 2010.
- [13] N. Carvalho and J. C. Pedro, "A comprehensive explanation of distortion sideband asymmetries," *IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques*, vol. 50, no. 9, pp. 2090-2101, Sep. 2002.
- [14] G. Xiangqian, K. Hongwen, and C. Hongxing, *The Least-Square Method in Complex Number Domain*, Beijing, China, Mar. 2006.

محمد رضا متولی در سال ۱۳۶۹ مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد و دکتری را در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ به ترتیب در رشته‌های مهندسی الکترونیک و مهندسی الکترونیک فرکانس‌های بالا از دانشگاه‌های بynom و دیسیورگ آلمان دریافت نمود. نامبرده در حین تحصیل در آلمان با برخی از شرکت‌های آلمانی در انجام برخی پژوهش‌های مرتبط با رشته برق نیز همکاری می‌کرده است. از سال ۱۳۹۰ ایشان عضو هیات علمی گروه مخابرات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم می‌باشد. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان عبارتند از: طراحی مدارهای الکترونیکی به کمک تقویت‌کننده‌های عملیاتی، تقویت‌کننده‌های توان بالای RF، خطی‌کردن تقویت‌کننده‌های توان بالا و کاربرد آنها در سیستم‌های مایکروویو و ماهواره.

کلاوس سولباخ از سال ۱۹۹۵ میلادی دارای کرسی پروفوسری در رشته مهندسی الکترونیک فرکانس‌های بالا در دانشگاه دیسیورگ آلمان می‌باشد. نامبرده کارهای تحقیقاتی بسیاری در مجلات معتبر از جمله در IEEE منتشر نموده است. انتشار بیش از ۱۰۰ مقاله از وی، او را از صاحب نظران ممتاز در کشور آلمان کرده است. زمینه‌های تحقیقاتی و تخصصی ایشان عبارتند از: طراحی آنتن و مدارهای مایکروویو، مخابرات بی‌سیم و مهندسی پژوهشی.

جدول پ-۱: تقویت‌کننده A

$$\begin{aligned} C_1 &= -1,1335331 \cdot 10^{17} - j4,250375150 \cdot 627817 \times 10^{17} [-] \\ C_2 &= -4,2416814681244830 \times 10^{17} + j1,17033628721750 \cdot 4 \times 10^{17} \left[ \frac{1}{V^4} \right] \\ C_3 &= 1,398440421720 \cdot 199 \times 10^{17} - j1,639610319822552 \times 10^{17} \left[ \frac{1}{V^4} \right] \\ C_4 &= -1,958669900955511 \times 10^{17} + j3,234799401151145 \times 10^{17} \left[ \frac{1}{V^8} \right] \\ C_5 &= 1,248523974795798 \times 10^{17} - j2,734691259725923 \times 10^{17} \left[ \frac{1}{V^8} \right] \\ C_6 &= -3,657144975762186 \times 10^{17} + j1,040198540810 \cdot 10^{17} \left[ \frac{1}{V^{12}} \right] \\ C_7 &= 4,01365710244952 \times 10^{17} + j1,324195574622113 \times 10^{17} \left[ \frac{1}{V^{12}} \right] \end{aligned}$$

جدول پ-۲: تقویت‌کننده B

$$\begin{aligned} C_1 &= 9,883660687761525 \times 10^{17} - j4,603840472636214 \times 10^{17} [-] \\ C_2 &= -5,9149777990062957 \times 10^{17} - j5,39207200616908 \times 10^{17} \left[ \frac{1}{V^4} \right] \\ C_3 &= 1,923162782154115 \times 10^{17} + j1,231646171117435 \times 10^{17} \left[ \frac{1}{V^4} \right] \\ C_4 &= -3,114578514124075 \times 10^{17} - j7,973480506036523 \times 10^{17} \left[ \frac{1}{V^8} \right] \\ C_5 &= 2,256289760928274 \times 10^{17} + j4,8109332234649357 \times 10^{17} \left[ \frac{1}{V^8} \right] \\ C_6 &= -7,35077782165395 \times 10^{17} - j1,724215156449661 \times 10^{17} \left[ \frac{1}{V^{12}} \right] \\ C_7 &= 8,812393452813644 \times 10^{17} + j2,288917209005605 \times 10^{17} \left[ \frac{1}{V^{12}} \right] \end{aligned}$$

ثابت‌های حقیقی) نشان داده شده‌اند که دور از رفتار حقیقی تقویت‌کننده‌ها است. همان گونه که ملاحظه می‌شود انحراف زیادی بین نتایج مدل و اندازه‌گیری‌ها در محدوده دامنه‌های بزرگ برای سیگنال‌های ۳IMD مشهود است و از آنجایی که این محدوده برای مدل یک تقویت‌کننده توان بالا مهم است، مدل حاصل پذیرفتنی نیست. ملزم بودن پارامترهای سری تیلور به دو فاز ثابت  $0^\circ$  و  $180^\circ$  دلیل اصلی این انحراف است و به عبارت دیگر سری تیلور با ثابت‌های حقیقی فقط می‌تواند یک تبدیل AM/AM و نه تبدیل AM/PM را توصیف کند. با سری تیلور حقیقی، گردش یا تغییر فازها در مدل امکان ندارد.

(ب) ثابت‌های سری تیلور محاسبه شده برای دو تقویت‌کننده A و B به ترتیب در جداول پ-۱ و پ-۲ آمده‌اند.

## مراجع

- [1] S. Z. ASIF, *Wireless Communications Evolution to 3G and Beyond*, Artech House, 2007.